

Тематический указатель статей, опубликованных в 2023 году

Фундаментальные исследования

Волков Р. Л., Боргардт Н. И. Идентификация структуры наноразмерных слоев многослойных гетерокомпозиций методами просвечивающей электронной микроскопии. Т. 28, № 6, с. 711–726.

Материалы электроники

Аишотов О. Г., Аишотова И. Б., Магкоев Т. Т. Резистивные свойства конструкционных стекол микроканальных пластин. Т. 28, № 6, с. 727–733.

Бабич А. В., Волощук И. А., Шерченков А. А., Переверзева С. Ю., Глебова Д. Д., Бабич Т. А. Термическая стабильность толстых пленок на основе низкотемпературных термоэлектрических материалов систем Bi-Te-Se и Bi-Te-Sb, модифицированных добавками оксида меди. Т. 28, № 3, с. 281–286.

Горошко Д. Л., Гаврилин И. М., Дронов А. А., Горошко О. А., Волкова Л. С., Гревцов Н. Л., Чубенко Е. Б., Бондаренко В. П. Электрический транспорт в пористых структурах Si-Ge/c-Si, сформированных электрохимическим осаждением германия в пористый кремний. Т. 28, № 6, с. 734–744.

Громов Д. Г., Гаврилов С. А., Лебедев Е. А., Силибин М. В., Дубков С. В., Аникин А. В., Погалов А. И., Дронова Д. А., Бутманов Д. Д., Ширяев М. Е., Громов В. Д., Рязанов Р. М., Шарипов Р. А., Беспалов В. А. Управление составом тонких пленок Mo-Si-N-O при реактивном магнетронном распылении. Т. 28, № 6, с. 745–761.

Дмитриев В. К., Ильичёв Э. А., Кириленко Г. Г., Петрухин Г. Н., Рычков Г. С., Фролов В. Д. Характеристики и области возможных применений аморфных кремний-углеродных и металл-кремний-углеродных пленок. Обзор. Т. 28, № 1, с. 24–48.

Дронова Д. А., Дронов А. А. Исследование электрохимических свойств анода натрий-ионного аккумулятора на основе нанотрубчатого анодного TiO₂. Т. 28, № 1, с. 17–23.

Лавров И. В. Методы вычисления эффективных электрофизических свойств неоднородных сред с учетом многообразных структурных особенностей. Обзор. Т. 28, № 4, с. 403–430.

Морозова Е. В., Тимкаева Д. А. Нанотрубки на основе 2D-материалов SMoSiN₂ типа Янус для применений в наноэлектронике. Т. 28, № 3, с. 271–280.

Силаков Г. О., Лазоркина Е. Н., Гаврилов С. А., Воловликова О. В., Железнякова А. В., Дудин А. А. Исследование реакционной способности структуры por-Si/Pd по отношению к парам этанола. Т. 28, № 1, с. 7–16.

Тарасов А. М., Дубков С. В., Ву Ван Зунг, Киселев Д. А., Сиротина А. П., Волкова Л. С., Рязанов Р. М., Громов Д. Г. Исследование структурных и электрофизических свойств нанонитей титаната бария, полученных методом гидротермального синтеза. Т. 28, № 2, с. 151–163.

Технологические процессы и маршруты

Gromov D. G., Dubkov S. V., Savitskiy A. I., Gavrilov S. A. Features of the nanoparticles and binary nanoalloys formation during thermal evaporation and condensation on an inert surface in vacuum (Громов Д. Г., Дубков С. В., Савицкий А. И., Гаврилов С. А. Особенности формирования наночастиц и бинарных наносплавов при термическом испарении и конденсации на инертной поверхности в вакууме). Т. 28, № 1, с. 49–58.

Алексеев А. В., Переверзева С. Ю., Рязанов Р. М., Громов Д. Г. Особенности получения композитного электродного материала суперконденсатора УНТ/RuO₂·xH₂O методом электрофоретического соосаждения. Т. 28, № 1, с. 59–78.

Голишников А. А., Дюжев Н. А., Парамонов В. В., Потапенко И. В., Путря М. Г., Сомов Н. М., Чаплыгин Ю. А. Исследование и разработка процесса глубокого анизотропного травления кремния со сниженной шероховатостью боковых стенок структур. Т. 28, № 6, с. 762–772.

Касумов Ю. Н., Пухаева Н. Е., Мовчан С. А., Гончаров И. Н., Урумов В. В. Разработка и исследование перфорированных структур для газовых электронных умножителей на базе фольгированных полиимидных пленок. Т. 28, № 3, с. 326–336.

Корчагин Е. П., Нагрешников Е. В., Штерн М. Ю., Рогачев М. С., Мустафоев Б. Р., Штерн Ю. И. Исследования факторов, влияющих на сопротивление контактов в термоэлементах. Т. 28, № 6, с. 773–783.

Нелюбин И. В., Путря М. Г. Особенности контроля трехмерного профиля элементов и структур наноразмерных ИС. Обзор. Т. 28, № 3, с. 298–325.

Новак А. В., Соколов А. М., Румянцев А. В., Новак В. Р. Исследование зависимости формы кремниевых игл от концентрации раствора КОН при жидкостном анизотропном травлении. Т. 28, № 3, с. 287–297.

Подорожний О. В., Румянцев А. В., Волков Р. Л., Боргардт Н. И. Моделирование процессов распыления материала и имплантации галлия при воздействии фокусированного ионного пучка на кремниевую подложку. Т. 28, № 5, с. 555–568.

Тимаков А. В., Горноста́й-Польский В. С., Шевяков В. И. Многоуровневая металлизация высокотемпературных кремниевых ИС на основе вольфрама. Физика и технология. Обзор. Т. 28, № 2, с. 164–179.

Элементы интегральной электроники

Белов Е. Н., Королёв М. А. Исследование влияния электрического переходного процесса на результаты измерения теплового сопротивления ИС косвенным методом на основе термочувствительного параметра. Т. 28, № 1, с. 79–87.

Дюжев Н. А., Евсиков И. Д. Вакуумная наноэлектроника на основе полупроводниковых автоэмиссионных структур: текущее состояние и перспективы развития. Обзор. Т. 28, № 5, с. 569–599.

Кириллова А. В., Королёв М. А. Исследование влияния плавающего кармана на характеристики КНИ КМОП-транзисторов. Т. 28, № 2, с. 180–188.

Московская Ю. М., Бойченко Д. В. Прогнозный контроль радиационной стойкости микросхем в серийном производстве. I. Система и алгоритмы реализации для различных категорий изделий. Т. 28, № 2, с. 189–201.

Московская Ю. М., Бойченко Д. В. Прогнозный контроль радиационной стойкости микросхем в серийном производстве. II. Выбор объектов испытаний и статистическая обработка результатов контроля. Т. 28, № 3, с. 337–350.

Сауров М. А. Оптимизация параметров преобразователя излучения на основе кремниевого $p-i-n$ -диода. Т. 28, № 4, с. 431–440.

Смирнов В. И., Гавриков А. А. Исследование теплоэлектрических свойств мощных MOSFET-транзисторов. Т. 28, № 5, с. 600–611.

Якунина Н. В., Некрасов Н. П., Неволин В. К., Бобринецкий И. И. Переключение проводимости в латеральных каналах на основе максенов $Ti_3C_2T_x$. Т. 28, № 1, с. 88–95.

Схемотехника и проектирование

Melikyan V. Sh., Ghukasyan S. A., Harutyunyan S. S., Voskanyan G. A., Asatryan N. A. A method for minimizing aging influence on rail-to-rail operational amplifier with thin oxide transistors (*Меликян В. Ш., Гукасян С. А., Арутюнян С. С., Восканян Г. А., Асатрян Н. А.* Метод минимизации влияния старения на rail-to-rail операционный усилитель с тонкими оксидными транзисторами). Т. 28, № 3, с. 351–359.

Melikyán V. Sh., Vardumyan A. V., Harutyunyan A. G., Asatryan N. A., Melikyán Sh. V., Karapetyan E. Y. System for automated IC design based on generative adversarial and artificial deep neural networks

(Меликян В. Ш., Вардумян А. В., Арутюнян А. Г., Асатрян Н. А., Меликян Ш. В., Карапетян Э. Е. Система автоматизированного проектирования ИС, основанная на генеративно-сопоставительной и искусственной глубокой нейронных сетях). Т. 28, № 5, с. 612–620.

Дворников О. В., Чеховский В. А., Прокопенко Н. Н., Чумаков В. Е. Входные каскады программируемых быстродействующих операционных усилителей на основе базового матричного кристалла МН2ХА031. Т. 28, № 5, с. 629–641.

Крупкина Т. Ю., Лосев В. В., Беневоленский С. Б., Хлыбов А. И., Родионов Д. В. Влияние потерь в соединениях при измерении коэффициента усиления и коэффициента шума на анализаторе спектра. Т. 28, № 6, с. 794–801.

Лагунович Н. Л. Двумерное моделирование эмиттерного $p-n^+$ -перехода кремниевого $n-p-n$ -транзистора в прямоугольной и цилиндрической системах координат. Т. 28, № 5, с. 621–628.

Петросянец К. О., Силкин Д. С., Попов Д. А., Исмаил-Заде М. Р., Харитонов И. А., Переверзев Л. Е., Морозов А. А., Тургенев П. В. Особенности TCAD- и SPICE-моделирования удара заряженной частицы в 6Т-ячейку статической памяти, изготовленную по КМОП-технологии с проектными нормами 28 нм. Т. 28, № 6, с. 826–837.

Раков А. В., Шевцов И. В., Борин О. В., Горшкова Н. М., Скок Д. В. Методика оценки S-параметров высокоскоростных путей передачи сигналов в корпусах микросхем. Т. 28, № 6, с. 802–813.

Раннев Н. Ю., Кондратенко С. В., Дубинский А. В., Горшкова Н. М., Скок Д. В. Высокоскоростной перестраиваемый КМОП-усилитель-ограничитель для приемника сигнала оптической линии. Т. 28, № 6, с. 814–825.

Соболев В. А., Лосев В. В. Разработка RTL-модели генератора псевдослучайных чисел на основе регистров сдвига с нелинейной обратной связью в каскаде Голлмана. Т. 28, № 6, с. 784–793.

Солодовников А. П., Переверзев А. Л., Силантьев А. М. Программно-аппаратный комплекс для ускорения функциональной верификации систем на кристалле. Т. 28, № 4, с. 441–451.

Шариков А. И., Шарикова Е. М. Масштабируемая ПЛИС-система выборки и хранения данных для конвейерной обработки видеопотока. Т. 28, № 2, с. 202–211.

Шумарин С. В., Фролова Т. Н., Богачев А. М. Методика идентификации параметров Spice-моделей КМОП-микросхем по температурным зависимостям их динамических характеристик. Т. 28, № 2, с. 212–221.

Микро- и наносистемная техника

Баранов А. А., Грабов А. Б., Обижаев Д. Ю., Жукова С. А. Двухосевой однокристалльный АМР-преобразователь магнитного поля. Т. 28, № 4, с. 500–508.

Беляков И. А., Вертянов Д. В., Кочергин М. Д., Тимошенко С. П. Особенности проектирования и технологии изготовления трехмерной микросистемы с торцевой коммутацией. Т. 28, № 4, с. 471–488.

Галкин А. А., Еркин П. В., Захаров В. П., Соломкина Н. А., Тимошенко А. С., Тимошенко С. П. Применение инерциальных МЭМС в системе автоматической отцепки десантируемого груза. Т. 28, № 4, с. 489–499.

Грабов А. Б., Рискин Д. Д., Суздальцев С. Ю., Обижаев Д. Ю., Жукова С. А. Технология герметизации МЭМС на уровне пластины на базе SLID-структур, выращенных из электролитов на основе металлоорганических комплексов Cu-Sn. Т. 28, № 4, с. 461–470.

Карамышев В. П. Методики определения концентрации и подвижности в слоях областей пространственного заряда. Т. 28, № 2, с. 232–243.

Пайн Со Хту, Калугин В. В., Кочурина Е. С. Моделирование и оптимизация емкостного МЭМС-датчика ускорения гребенчатого типа. Т. 28, № 4, с. 452–460.

Пью Вин Тун, Симонов Б. М., Тимошенко С. П. Исследование возможностей повышения чувствительности МЭМС-датчика давления емкостного типа с мембранами различных геометрических форм. Т. 28, № 2, с. 222–231.

Тимошенко С. П., Тимошенко А. С., Анчутин С. А., Кочурина Е. С., Дернов И. С., Мусаткин А. С., Лебедев А. А. Исследование влияния степени вакуумирования на добротность колебательного контура чувствительного элемента МЭМС-датчика. Т. 28, № 5, с. 642–648.

Интегральные радиоэлектронные устройства

Гулаков И. Р., Зеневич А. О., Кочергина О. В. Исследование плоского угла зрения кремниевых фотоумножителей. Т. 28, № 3, с. 360–367.

Дворников О. В., Чеховский В. А., Прокопенко Н. Н., Галкин Я. Д., Куниц А. В., Чумаков В. Е. Быстродействующие широкополосные операционные усилители на базовом матричном кристалле. Т. 28, № 1, с. 96–111.

Карачев Е. В., Благодатский Г. А., Смирнов С. В. Информационная система поддержки принятия решений по управлению режимами работы когнитивного радио. Т. 28, № 2, с. 244–251.

Колесников Е. Б. Управляемый фазовращатель гармонического сигнала. Т. 28, № 4, с. 509–517.

Курчанов А. Ф., Слюсарев С. Н., Овчинников С. Н., Сальников А. С. Миниатюрный стандарт частоты на основе КПП в Cs. Т. 28, № 5, с. 649–658.

Биомедицинская электроника

Жило Н. М. Управление удалением жидкости в системе автоматизированного перитонеального диализа. Т. 28, № 4, с. 518–528.

Информационно-коммуникационные технологии

Гагарина Л. Г., Букарев А. В. Метод автоматизированного тестирования устройств потребительской электроники с помощью удаленного вызова процедур и облачных сервисов. Т. 28, № 5, с. 687–699.

Ефанов Д. В., Зуева М. В. Коды с суммированием с сериями перестановок весов между информационными векторами для систем технического диагностирования. Т. 28, № 1, с. 112–128.

Ефанов Д. В., Погодина Т. С. Самодвойственные отказоустойчивые структуры с контролем вычислений по паритету. I. Структуры на основе дублирования и метода логической коррекции сигналов. Т. 28, № 5, с. 670–686.

Ефанов Д. В., Погодина Т. С. Самодвойственные отказоустойчивые структуры с контролем вычислений по паритету. II. Моделирование работы цифровых устройств при неисправностях. Т. 28, № 6, с. 838–853.

Кузнецова Е. С. Методика перехода к электронным конструкторским документам для автоматизации нормоконтроля. Т. 28, № 4, с. 529–536.

Макаров А. И., Мунерман В. И. Использование $(0, \mu)$ -свернутого произведения многомерных матриц для решения задач теории графов. Т. 28, № 5, с. 659–669.

Сотников А. В., Шипатов Е. А., Шипатов А. В. Алгоритм выделения объектов на изображениях на основе слияния суперпикселей. Т. 28, № 1, с. 129–139.

Чипчагов М. С., Кублик Е. И., Попов В. А. Алгоритм индексации объектов рекомендательной системы. Т. 28, № 2, с. 252–260.

Шевнина Ю. С., Гагарина Л. Г., Климочкина М. А., Попова Т. В. Метод формирования контента для тематических порталов на основе интеллектуального анализа данных. Т. 28, № 3, с. 368–377.

Шевнина Ю. С., Гагарина Л. Г., Конюхов Е. В., Харитонова А. Д. Метод кластерного анализа гетерогенных данных с использованием положений нечеткой логики. Т. 28, № 4, с. 537–546.

Щербов И. Л. Апробация работы алгоритма адаптивного нелинейного оптимального сглаживания многопараметрических данных траекторных измерений. Т. 28, № 3, с. 378–384.

Краткие сообщения

Смирнова В. П., Крупкина Т. Ю. Моделирование средствами TCAD воздействия тяжелых заряженных частиц на *n*-МОП-структуру в составе ячейки памяти. Т. 28, № 3, с. 385–390.

Юбилей

Беспалову Владимиру Александровичу – 65 лет. Т. 28, № 5, с. 700.

Королёву Михаилу Александровичу – 90 лет. Т. 28, № 2, с. 261–262.

Красникову Геннадию Яковлевичу – 65 лет. Т. 28, № 3, с. 391–392.

Селищеву Сергею Васильевичу – 70 лет. Т. 28, № 5, с. 701.

Сидоренко Анатолию Сергеевичу – 70 лет. Т. 28, № 5, с. 702.

Конференции

XXX Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Микроэлектроника и информатика – 2023» с международным участием. Т. 28, № 1, с. 142.

Вторая объединенная конференция «Электронно-лучевые технологии и рентгеновская оптика в микроэлектронике» (13–16 ноября 2023 г., г. Черноголовка). Т. 28, № 5, 2-я стр. обложки.

Гагарина Л. Г. Об итогах III Научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы информатизации в цифровой экономике и научных исследованиях – 2022». Т. 28, № 1, с. 140–141.

Об итогах XXX Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Микроэлектроника и информатика – 2023» с международным участием. Т. 28, № 3, с. 393–394.

Российский форум «Микроэлектроника 2023». Т. 28, № 4, 2-я стр. обложки.

Информация для читателей журнала

«Известия высших учебных заведений. Электроника»

С тематическими указателями статей за 1996 – 2022 гг., аннотациями и содержанием последних номеров на русском и английском языках можно ознакомиться на сайте:

<http://ivuz-e.ru>